Eduardo Borges Lima., EQ/UFRJ pg.1 2019

#### Evolução dos materiais

#### Idade da Pedra

Materiais mais comuns: Polímeros (madeiram peles e fibras); Cerâmicos (Pedra)

#### Idade da Argila

Materiais mais comuns:

#### **Idade do Cobre**

Materiais mais comuns:

#### **Idade do Bronze**

Materiais mais comuns:

Idade do Ferro

Materiais mais comuns:

#### 2 Sociedade e Materiais

Aumento significativo de tipos de materiais com o desenvolvimento industrial ⊳ Melhoria nos métodos de extração e produção & Alterações nos materiais para formação de novos materiais (materiais avançados, compósitos)

#### 3 Classificação dos Materiais

#### Metais

Combinação de elementos metálicos, sendo possível a presença de não-metálicos (ex: açocarbono). Algumas propriedades relacionadas à presença de elétrons livres (ex: bons condutores de calor e eletricidade). Resistentes e deformáveis: extenso uso em aplicações estruturais. Suscetível a corrosão.

Possui boa condutividade térmica e elétrica.

#### Cerâmicos

ligações de metais e não-metais. Isolantes térmicos e elétricos. Podem ser resistentes a altas temperaturas e a ambientes agressivos. Ex: óxidos, nitretos, carbetos. Resistentes a corrosão.

Possui boa condutividade térmica e variada condutividade elétrica.

#### Polímeros

polímeros:compostos orgânicos. Baixa densidade; altamente deformáveis. (C, H e nãometálicos) Degrada com solventes, altas temperaturas.

Possui baixa condutividade térmica e elétrica. Compósitos

Compósitos: dois ou mais tipos de materiais unidos de forma a produzir um material com características específicas. Projetados para apresentar uma combinação das melhores características de cada um dos componentes.

#### Materiais avancados

Uso em aplicações de ponta(alta tecnologia). Não necessariamente são novos materiais. Podem ser tradicionais, com otimização das propriedades.

- Alto desempenho
- Baixo peso e alta resistência
- Resistência a diversas condições de ser-
- · Ambientalmente corretos
- Facilmente recicláveis

Ex: polímero reforcado com fibra de vidro usado como armadura para estruturas em concreto armado

#### 4 Classificação dos Materiais Qaunto a Estrutura

- Ligações atômicas
  - Metálica
  - covalente
  - iônica
- Tipo de Estrutura
  - Amorfa
  - Cristalina
  - Molecular

#### **Propriedades Mecânicas**

- dutilidade
- elasticidades
- dureza
- · tenacidade

#### Propriedades Ouímicas e Físicas

- ponto de fusão
- calor específico
- condutividade (térmica e elétrica)
- Propriedades magnéticas
- Propriedades ópticas
- Iteração com o ambiente: oxidação

#### Modificação das Propriedades

- Tratamentos térmicos
- tratamento de superfície
- Tratamentos mecânicos

#### 5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA x PROPRIE-**DADES FÍSICAS**

Exemplo 1: alteração de cor de um mesmo mineral

CORÍNDON:mineral à base de óxido de alumínio (Al2O3) Chama-se safira qualquer variedade de corindon, de qualidade gemológica, que não seja vermelha (rubi)

Exemplo 2: Alteração da compatibilidade química com o meio ambiente. Aço patinável (CORTEN): aço com adição de cobre que forma uma pátina, reduzindo o processo corrosivo. Muito usado na construção civil.

#### **6 ESTRUTURA CRISTALINA x PROPRIE-**DADES FÍSICAS

CaCO3

Mármore (calcita -romboédrico)

#### Conchas (aragonita -ortorrômbico) 7 TIPO DE LIGAÇÃO QUÍMICA x PROPRI-

**EDADES FÍSICAS** O tipo de ligação iônica está intimamente ligada com as características físico-química dos materiais.

Temos que:

#### Ligações Metálicas

Favorecem a condutividade térmica e elétrica

#### Ligações Covalentes

Aparecem em matérias com características isolantes.

#### 8 Materiais de Construção

#### Escolha do Material

Etapas básicas

- relacionar experiências prévias para o serviço em questão
- relacionar e colocar em ordem de prioridade todos os parâmetros que podem influenciar na escolha

- estabelecer as características que se deseja para o material ideal ao serviço
- realizar testes, comparando os materiais que possam ser usados otimizando o custo total.

Definição da categoria do material: metal, cerâmico, polímero ou compósito

#### Como selecionar um material?

Condições operacionais

- Custo/benefício (indústria de massa ou de grande exigência tecnológica?)
- Propriedades requeridas
- Degradação no meio
- Solicitação mecânica
- Resistência/peso

#### Quais fatores influenciam na escolha dos materiais para determinado serviço ou aplicação industrial?

- Propriedades físicas e químicas
- Características operacionais
- Fabricação, disponibilidade e custo

#### 9 Propriedades físicas e químicas Propriedades mecânicas

Limites de escoamento e de resistência, dutilidade, resistência à fadiga e fluência, temperatura de transição dútil-frágil, módulo de elasticidade.

#### 9.1 Outras propriedades físicas

densidade, calor específico, expansão térmica, condutividade, propriedades magnéticas e elétricas.

#### Propriedades químicas

oxidação, flamabilidade, toxicidade.

#### 10 Características operacionais temperatura

natureza dos fluidos em contato com material (composição química, concentração, pH, caráter oxidante ou redutor, presenca de contaminantes, pressão, velocidade do fluido, flamabilidade, toxidez). Necessário avaliar alterações em cada um destes fatores ao longo do tempo de servico.

## presenca de resíduos oriundos de processos

ex: alguns materiais como o chumbo são resistentes à corrosão porém geram resíduos tóxidos, limitando seu uso.

## 11 Fabricação, disponibilidade e custo

#### Fatores críticos na seleção:

facilidade de fabricação e forma de apresentacão. Ex:espessura de chapas e formato(tubos ou tarugos) Custo/benefício: custo direto do material, tempo de vida útil e custos indiretos (paradas para reparos ou reposição dos equipamentos). Tempo de vida útil compatível com tempo previsto de operação. Relação direta com segurança (acidentes e falhas) Furos em tubulações. Aco inox 304 no lugar de aço-C. Aço-carbono disponível em inúmeras formas de fabricação.

#### 12 Estrutura Cristalina

#### Material Amorfo X Cristalino

O material CRISTALINO possui arranjo mais uniforme e as moléculas está direcionadas de forma a apresentarem um densidade molecular maior.

O material AMORFO possui suas moléculas dispostas de forma mais aleatória e a densidade molecular dessa região é menor.

#### CRISTALINIDADE

Arranjo interno ordenado das partículas segundo um modelo tridimensional, característico do estado sólido. Em muitos corpos a cristalinidade é evidenciada por faces e simetria externa, indicando um arranjo ordenado dos átomos. Exames em raios X(1912) estudo de substâncias inorgânicas.

#### **CRISTALOGRAFIA**

Estudo dos corpos sólidos que possuem estrutura cristalina e das leis que governam seu crescimento, forma externa e interna. É instrumento fundamental na química, física, metalurgia e no estudos das cerâmicas, refratários, semicondutores, gemas sintéticas, etc.

#### **CÉLULAS UNITÁRIAS**

para a maioria dos cristais, as células unitárias podem ser representadas por geometrias específicas. Mais do que uma célula unitária pode ser escolhida para representar o cristal. Geralmente, escolhe-se a que apresenta o maior grau de simetria geométrica.

#### SISTEMAS CRISTALINOS

Qualquer empacotamento atômico deverá se encaixar em um dos sete principais tipos de cristais, que estão intimamente associados com o modo pelo qual o espaco pode ser dividido em volumes iguais, pela interseção de superfícies planas. Existem diferentes estruturas cristalinas possíveis. É conveniente dividilas em grupos de acordo com as configurações das células unitárias e/ou os arranjos atômicos. Para criar todos os tipos de redes são necessários sete tipos distintos de células cristalinas.

#### 13 Células unitárias e Sistemas cristali-

Parâmetros de rede cristalina:

- a,b,c comprimentos dos lados do paralelepípedo
- $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ângulos entre os eixos

Com base nestes parâmetros de rede, tem-se que existem 7 diferentes combinações possíveis entre a,b,c e  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  cada um representando um sistema cristalino.





 $\alpha = \beta = 90^{\circ}, \gamma = 120^{\circ}$ 



rhombohedral a = b = c



a=b≠c

 $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$ 

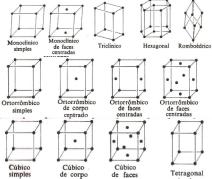




O maior grau de simetria aparece no sistema cúbico e o menor grau é visto no sistema tri-

#### Variações na célula unitária básica

As possíveis redes podem ser descritas por 14 células unitárias (A.I. Bravais). Em algumas células unitárias existem alguns tipos básicos: simples, de corpo centrado e de faces centradas.



#### Características

Numero de Coordenação: número de partículas que envolvem uma partícula central. Fator de empacotamento: volume de átomos numa célula unitária / volume da célula uni-

#### Valores para alguns sistemas cristalinos

- NC: Número de Coordenação
- FE: Fator de empacotamento

Cubo simples - CS

- NC: 6;
- FE:  $\frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{a^3} = 0,52$ ;
- Rel: a = 2R:

Cúbico de Corpo Centrado - CCC

- FE:  $2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{a^3} = 0,68$
- Rel:  $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$

Cúbico de Faces Centradas - CFC

• NC: 12

Cimat Eduardo Borges Lima., EQ/UFRJ pg.2 2019

• FE:  $4 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{a^3}$  0,74

• Rel:  $a = \frac{4 \cdot R}{\sqrt{2}}$ 

#### Hexagonal

• NC: 12

• FE: 0,73 (=CFC)

• Rel: a = 2R

Coordination number	Radius ratio, r/R	Coordination geometry
2	$0 < \frac{r}{R} < 0.155$	0-0
3	$0.155 \le \frac{r}{R} < 0.225$	Å
4	$0.225 \le \frac{r}{R} < 0.414$	<b>X</b>
6	$0.414 \le \frac{r}{R} < 0.732$	
8	$0.732 \leq \frac{r}{R} < 1$	
12	1	

## Raios Iônicos para Vários Cátions e Ânions (para um Número de Coordenação de 6)

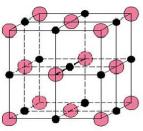
Cátion	Raio Iônico (nm)	Ânion	Raio Iônico (nm)	
Al <sup>3+</sup>	0.053	Br-	0,196	
$Ba^{2+}$	0,136	Cl-	0,181	
Ca <sup>2+</sup>	0,100	$F^-$	0,133	
Cs <sup>+</sup>	0.170	I-	0,220	
Fe <sup>2+</sup>	0,077	$O^{2-}$	0,140	
Fe <sup>3+</sup>	0.069	S <sup>2-</sup>	0.184	
$K^+$	0,138			
$Mg^{2+}$	0,072			
Mn <sup>2+</sup>	0,067			
Na <sup>+</sup>	0.102			
Ni <sup>2+</sup>	0,069			
Si <sup>4+</sup>	0,040			
Ti <sup>4+</sup>	0.061			

#### 14 Estrutura dos materiais Cerâmicos

O posicionamento das partículas nos materiais cerâmicos depende da relação entre os raios(cátion/ânion) e das cargas envolvidas. Nos vazios (sítios ou interstícios) da rede cristalina se posicionam partículas diferentes das que existem na rede cristalina principal. Em redes compactas há espaços intersticiais, onde as partículas ficam equidistantes do centro do espaço vazio.

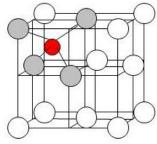
#### Posições octaédricas na rede cfc:

- NC: 6
- Local:arestas (3 sítios) + centro da célula unitária
- Total: 4 partículas (1 por partículas da célula unitária)



#### Posições tetraédricas na rede cfc:

- NC: 4
- Local:posições do tipo  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$
- Total: 8 partículas (2 por partículas da célula unitária)



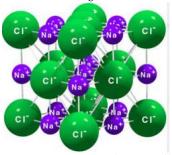
#### 15 Estrutura dos Materiais Cerâmicos

FEI=fator de empacotamento iônico As estruturas são bastante complexas, podendo-se representar alguns tipos mais comuns:

- Cerâmicostipo MaM'bXc
- MX
- MX2
- $M_2X_3$
- *MM'X*<sub>3</sub>
- $M'M''_2X_4$

M –elemento metálico X–elemento não-metálico Estrutura tipo MX -NaCl

Ex 1: NaCl (cfc) NC = 6 A estrutura pode ser vista como duas estruturas CFC, uma de íons sódio e uma de íons cloro. 2 íons associados(1 Na+e 1 Cl-) 4 íons de cada (CFC –4 átomos por célula unitária) São 8 íons por célula unitária. Outros compostos com esta estrutura: CaO, NiO, FeO, MgO.

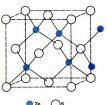


Estrutura tipo MX -CsCl Ex2: CsCl(ccc)



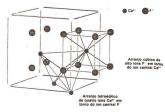
Estrutura cúbica (NC = 8)

Estrutura tipo MX -ZnS Ex3: ZnS(cfc) cfc:8 íons por célula unitária (4 Zn2+e 4 S2-) 4 S2-em posição cfce Zn2+em 4 sítios tetraédricos (1/2 dos sítios tetraédricos ocupados)



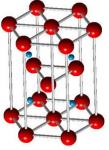
Estrutura tipo MX2 –CaF2 Ex: CaF2(cfc) -FLUORITA

3 íons associados ( $1Ca^{+2}e^{2}F^{-}$ ) 4 íons Ca+2 (estrutura cfc) e 8 íons F-(12 íons por célula unitária) Volume não preenchido próximo ao centro da célula unitária.



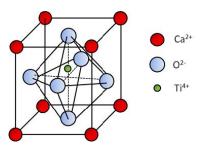
#### Estrutura tipo M2X3

Ex: Al2O3–alumina ou corundum 30 íons por célula unitária (12Al+3e18O2-) 2/3 dos interstícios ocupados por íons alumínio. Outros compostos com esta estrutura:-Fe2O3,Cr2O3.



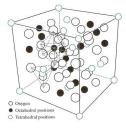
Estrutura tipo MM'X3

MeM'– elementos metálicos X –elemento nãometálico Ex: CaTiO3(combinação de estruturas cs, cc, cfc)–importante família de materiais cerâmicos usados na indústria eletrônica (propriedades piezoelétricas). Ca+2nos vértices, Ti+4como corpo centrado e O2-na faces. Este tipo de rede é um exemplo da estrutura CS formada pelos íons cálcio. Existem 5 íons por célula unitária (1Ca+2,1Ti4+e3O2) Outro composto com esta estrutura: BaTiO3.



Estrutura tipo MM2'X4

M(valência+2)eM'(valência+3)—elementos metálicos X —elemento não-metálico Ex: MgAl2O4(cfc)-importante família de materiais cerâmicos magnéticos (espinélios). 56 íons por célula unitária (8Mg+2,16Al3+e32O2-), Outros compostos com esta estrutura: NiAl2O4,MgAl2O4,ZnFe2O4.



#### 16 Estruturasdos Silicatos

Formam a classe máxima entre os minerais.

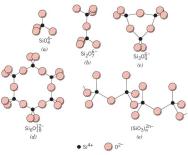
- A estrutura é complexa, não podendo ser definida como um tipo simples de estrutura, variando em função da temperatura e pressão.
- A característica geral dos silicatos é a mesma (tetraedros unidos) diferenciando em relação ao compartilhamento dos oxigênios.

Várias estruturas de silicatos surgem das diferentes maneiras segundo as quais unidades de (SiO4)-4 se unem formando arranjos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais.

#### Para Desenhar e anotar

Para os vários minerais à base de silicatos, 1, 2 ou 3 átomos de oxigênio nos vértices dos tetraedros são compartilhados por outros tetraedros para formar estruturas complexas.

Podem conter vários elementos em combinação com o silício e o oxigênio (ex: Na, K, Ca, Mg, Al e Fe).



Pirosilicato Piroxenio Anfibolio Rede (camada) Estrutura trid. Sem ordem

- tetraedros simples ex: Mg2SiO4
- tetraedros duplos ex: Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O)
- anéis (unidade estrutural (SiO3)-2)
- camadas ex: talco Mg3(Si2O5)2(H2O))
- redes (feldspatos, zeólitas, quartzo: SiO2) )

Ex 1:SiO2(cfc) -CRISTOBALITA 6 íons associados (2 Si+4e 4 O-2): Si2O4 24 íons por célula unitária(8 Si+4e 16 O-2) Apesar da grande célula unitária necessária para descrever a estrutura, é uma das formas mais simples do SiO2.

#### Ex2: Grupo dos feldspatos

X Al(1-2)Si(2-3) O8

onde: Quando X tem carga +1, há 1Al e 3Si X = Na+, K+ou Ca2+ Quando X tem carga +2, há 2Al e 2Si. Quanto maior a quantidade de Ca, maior a quantidade de Al no feldspato. Os Si e os Al ocupam os centros de tetraedros interconectados. Os cátions X se situam nos vazios da estrutura.

Ex3: Alumino-silicatos Alumínio pode entrar em Coordenação tetraédrica(em substituição ao Si) ou em Coordenação octaédrica, unindo tetraedros. Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+e o Ti4+tendem a ocorrer nas estruturas dos silicatos em coordenação octaédrica (em relação ao O2-). Ca2+ (0,99 Å) e Na+(0,97 Å) (cátions maiores e de carga mais fraca) entram em coordenação cúbica (NC = 8). Se um cátion trivalente substitui um tetravalente, ex: Fe3+na posição do Ti4+, outra substituição tem de ser feita no cristal de forma a perder uma carga positiva ou ganhar uma negativa eletroneutralidade.

**Ex4: Sílica vítrea** SiO2 sem arranjo cristalino regular

#### 17 Formação de mamteriais cristalinos

Materiais alotrópicos ou polimórficos apresentam mais de uma estrutura cristalina. **Alotropia**: substâncias puras.

Eduardo Borges Lima., EQ/UFRJ pg.3 2019

#### Polimorfismo: Substancias compostas

Metal	Estrutura cristalina à temperatura ambiente	A outras temperaturas
Ca	CFC	CCC (>447°C)
Co	HC	CFC (>427°C)
Hf	HC	CCC (>1742°C)
Fe	CCC	CFC (912-1394°C
		CCC (>1394°C)
Li	CCC	HC (<-193°C)
Na	CCC	HC (<-233°C)
TI	HC	CCC (>234°C)
Ti	HC	CCC (>883°C)
Y	HC	CCC (>1481°C)
Zr	HC	CCC (>872°C)

O processo de formação de cristais pode ser através de processo natural, em laboratório ou na indústria.

O crescimento se dá sob forças acidentais, presença de íons estranhos, variação da tempera-

Podem ainda ser feitor a partir:

- Solução;
- · Vapor;
- Massa em fusão.

Cada ponto de cristalização é chamado de núcleo de cristalização e a formação destes núcleos pode ser:

- · Homogênea: núcleos formados pelos átomos de próprio metal
- · Heterogênea: núcleos formados sobre um substrato ou outro material presente. Requer menor energia para formação de núcleo estável do que na própria substância.

A depender do número de núcleos presentes no material, este pode ser classificado como monocristalino e policristalino. As propriedades mecânicas podem variar de acordo com o número de núcleos cristalinos.

É observado experimentalmente que os materiais policristalinos apresentam defeitos, i.e. rachaduras e falhas, nas regiões entre os núcleos de cistalização.

#### 18 Soluções Sólidas

Poucos metais são utilizados na sua forma pura. Sendo assim, grande parte dos materiais são chamados de ligas metálicas por haver combinação de dois ou mais metais.

Se o limite de solubilidade é ultrapassado, uma nova fase é formada e observada nesses materiais.

Exemplos de ligas metálicas:

- Ligas de cobre: latão / bronze / cuproníquel atãobronze
- · Ligas de níquel: monel/inconel/inco-
- Ligas ferrosas: Aço-C / Aços inoxidá-

#### 19 Elementos de Liga

Os elementos de liga são impurezas adicionadas intencionalmente e podem promover a melhora de algumas propriedades desses materiais e torná-lo útil para outras aplicações tecnológicas. Algumas características são:

- · dopagem em semicondutores;
- · maior resistência mecânica;
- · maior resistência a corrosão;
- maior condutividade elétrica;
- melhor soldabilidade.

#### 20 Soluções Sólidas

Tipos de soluções sólidas:

- substitucional: o átomo do elemento acrescido a liga substitui a posição de um dos átomos presentes na célula cristalina:
- intersticial: o átomo do elemento acrescido a liga invade o interstício dos átomos que formam a célula cris-

As soluções sólidas SUBSTITUCIONAIS podem ainda ocorrer de forma

- · Ordenada;
- Ao acaso.

#### Regras de Hume-Rothery

- Variação % causada pela diferença entre raios < 15% (evitar distorções na rede): raio soluto = raio solvente/
- · Mesma estrutura cristalina;
- Eletronegatividades semelhantes
- Mesma valência.

Sistema	∆ Raios (%)	Solubilidade (%)
Cu-Zn	3,9	38,3
Cu-Pb	36,7	0,1
Cu-Ni	-2,3	100
Cu-Al	11,7	16,4

# VER COMO É ESSA REGRA EM UM LI-VRO DAS REF NECESSÁRIO MINAR ESSE

#### 22 Imperfeições Cristalinas

É uma imperfeição no arranjo periódico regular dos átomos em um cristal. Podem estar relacionada à posiçãodos átomos ou ao tipo de átomo presente na rede.

O tipo e o número de defeitos dependem do meio ambiente, do material e das circunstâncias sob as quais o cristal é processado.

> • Representam pequena fração da rede mas podem significar muito nas propriedades dos materiais.

mentos de liga formando novos mate-

#### Defeitos pontuais:

- Lacunas ou vazios simples ou não.
- Originadas por perturbações locais durante a solidificação ou vibrações térmicas a altas temperaturas.

#### Defeitos em sólidos iônicos:

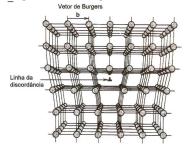
- Defeito de Schottky: vazio de par de íons (exclusivo de materiais iônicos) AX →par consistindo de lacuna de cátion e lacuna de ânion → neutrali-
- Defeito de Frenkel: deslocamento de um íon para um interstício (muita energia adicional) →lacuna de cátion + cátion intersticial →Não existe alteração de cargaImperfeições

#### Contorno de grãos:

- Formada entre cristais (contornos de grãos) ou nas superfícies externas.
- No contorno dos grãos, os átomos não estão à mesma distância uns dos outros. Há tensões de tração e compres-
- Influenciam nas propriedades físicas (ex: resistência mecânica) e químicas.
- Ajuste do tamanho dos grãos → uma das formas de controle das propriedades de um metal.
  - Ex: Reduzindo o tamanho dos grãos, há aumento do área de contorno de grão, diminuindo a distância percorrida pelas discordâncias aumento da resistência mecânica do material.

#### Defeitos de linha:

São imperfeições lineares em cristais, que envolvem a aresta de um plano extra de átomos. Podem ser originados durante solidificação ou por deformação plástica.



- · Os defeitos (discordâncias, defeitos pontuais e contornos de grãos) atuam como barreiras para as discordâncias.
- O cisalhamento se dá mais facilmente nos planos de maior densidade atômica, que depende a orientação cristalográfica.

 Podem permitir a introdução de ele Fundamentos da Ciência e Eng. dos Materiais –uma abordagem integrada, Willian D. Callister, 2aed., Livros Técnicos e Científicos Editora, 2006.

Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. William F. Smith, 3a ed, Editora Mc Graw

Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, Willian D. Callister, 5a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora, 2002.

## Direções Cristalinas Slide 04

### 23 Direções Cristalográficas

- Propriedades direcionais: Ex módulo de elasticidade do Fe maior na diagonal do cubo do que na aresta.
- · Direções cristalinas são indexadas através de um segmento que se estende da origim até determinada posicão dentro do cristal.
- Três índices são usados para designação das direções:
- Índices de Müller→ Base: célula unitária com sistema de coordenadas cartesianas, com origem em um vértice da célula.
  - Vetor posicionado de forma a passar pela origem do sistema de coordenadas cartesianas. Pode ser transladado, desde que seja mantido um paralelismo com o vetor na ori-
  - O comprimento da projeção do vetor em cada eixo é determinado em relação aos parâmetros de rede a, be c.
  - Reducão dos valores ao menor número inteiro por multiplicação ou divisão por um fator co-
  - Os três índices não são separados por vírgulas e ficam entre colchetes. [u v w]

u v w correspondem às projeções nos eixos x, y e z, respectivamente.

 Em cristais cúbicos, as direções do tipo [111] (índices negativos e positivos) são iguais e identificadas por <111>.

## no slide 04 podemos achar alguns exemplos do índice de Müller para sólidos

#### Densidade de Sólidos

- Densidade volumétrica:  $D_v$ = massa por célula unitária / volume da célula
- Densidade Linear:  $D_l$ = átomos centrados sobre o vetor direção / comprimento do vetor direção

#### Slide 05. Planos Cristalinos e densidade planar

#### 25 Planos cristalinos

Planos de átomos ou íons influenciam as propriedades e o comportamento dos materiais.

Os três índices não são separados por vírgulas e ficam entre parênteses.  $\rightarrow$  (h k l)

Em cristais cúbicos, alguns planos constituem uma família de planos. Ex: (100) (010) (001) etc  $\rightarrow$  h k l Família de

planos

No sistema hc os planos são designados por 4 índices (h k i l), que se referem a quatro eixos coordenados: 3 eixos na base do hexágono (120o entre si) e 1 eixo na vertical.

# Determinação do Índice de Müller -

Os índices correspondem ao inverso das distâncias das interseções do plano com os eixos à origem.

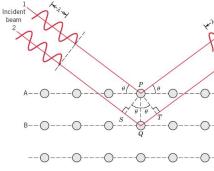
São considerados os parâmetros de rede (a, b , c) como unidade para definição dos índices de Miller.

## CONSULTAR SLIDE PARA EXEMPLOS DE PLANOS CRISTALINOS

#### 27 PLANOS CRISTALINOS vsCaracterização de estruturas

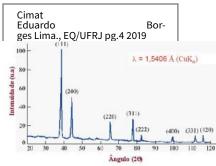
DIFRAÇÃO DE RAIOS-X Técnica de caracterização estrutural de estruturas cristalinas. O bombardeamento de amostras com feixes de elétrons, gera emissão característica dos elementos constituintes.

A avaliação da estrutura cristalina pode ser feita por difratogramas produzidos por ondas que interagem com os átomos e que possuem comprimentos de onda com ordem de grandeza das distâncias interatômicas.

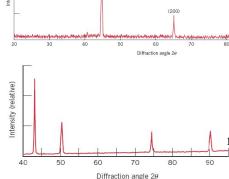


Como funciona:

- Incidência de feixe de raios-X com ângulo de incidência  $\theta$ sobre planos cristalinos com distância interplanar d.
- · Emissão característica dos elementos constituintes.



A avaliação da estrutura cristalina pode ser feita por difratogramas. Um feixe de raios-X é direcionado ao material cristalino e difratado pelos planos dos átomos ou íons com comprimentos de onda na ordem de grandeza das distâncias interatômicas.



A mistura de amostras é revelada no difratograma com a superposição dos padrões individuais. Ex: Quartzo e NaCl (ver difratogramas do slide 05)

Densidade planar

 $D_p$ = átomos centrados sobre o plano / área do plano

#### Slide 06. DIFUSAO 28 Difusão em Sólidos

Def: O transporte de massa no sólido se dá através de movimento atômico. Casos práticos:

- Filtros para purificação de gases;
- · Modificação superficial de peças;
- · Dopagem de semicondutores;
- · Revestimentos.

#### 28.1 Cementação

- Mdificação superficial de peças;
- Aumento do teor de C na parte mais externa de engrenagens para aumentar a dureza. Fonte de carbono: pó de grafite ou em fase liquida ou gasosa.

#### 28.2 Galvanização

Imersão de pelas de aço em zinco fundido formando camadas de ligas Fe-Zn unidas metalurgicamente ao metal base. Temp. 445 a 455 Č.

#### 28.3 Difusão L-L

O potencia de difusão é dados pelo gradiente de concentração no sistema.

#### 28.4 Difusão S-S

Objetivo: Equalização da composição química em ligas. PROCESSO TERMICAMENTE ATI-

#### 28.4.1 Par de Difusão

Duas barras de materiais metálicos distintos sob o tratamento térmico. Concentrações de cobre e de níquel em função da posição no par de difusão.

concentrações de cobre e de níquel em função da posição no par de difusão.

#### 28.4.2 Condição para ocorrer difusão de átomos na rede cristalina

- Deve haver espaço livre (lacuna) adjacente ao átomo.
- atomo que se desloca deve possuir energia suficiente para quebrar as ligações química que o une a seus átomos vizinhos.
  - A movimentação dos átomos pode se dar pelo volume do material ou ao longo de defeitos cristalinos (mais rápida).

#### Mecanismos propostos:

- 1. Difusão por lacunas (ou difusão substitucional)
- 2. Difusão intersticial
- Difusão por lacunas (ou difusão substitucional): Átomo se desloca da posição padrão da rede cristalina para algum local (sitio) vazio próximo.
  - O átomo segue direção contrária ao movimento da lacuna.
  - Depende da quantidade de lacunas presentes na rede cristalina.
  - A quantidade de lacunas aumenta com a temperatura.
  - O processo é denominado AU-TODIFUSÃO quando os próprios átomos da rede se difundem ou INTERDIFUSÃO quando ocorre difusão de impurezas substitucionais.
- · Difusão intersticial
  - Átomos intersticiais migram para posições adjacentes da rede cristalina.

- Corresponde a um tipo importante de difusão em metais e ligas cuja impureza apresenta pequeno raio atômico em relação ao átomo da matriz cristalina. (ex: C e H)
- É geralmente mais rápida (apresenta maior coeficiente de difu-
- Menor energia necessária para o movimento dos átomos.

			teriao cottadada ( O)	NO/IIIOI
Zinco Alumínio Cobre Níquel Ferro-α Molibdénio	419 660 1083 1452 1530 2600	HC CFC CFC CFC CCC	240 — 418 400 — 610 700 — 990 900 — 1200 808 — 884 2155 — 2540	91,6 165 196 293 240 460
			(a)	Vacancy
	<u>0</u> 0 00 00		(b)	Interstitial
000	000	(		) Interstitialc
Excl	nange ((	00 30 00 00	000 000 000 000	~ Ring

#### 28.4.3 Fluxo de Difusão

A velocidade com que ocorre a difusão é avaliada em termos de FLUXO DE DIFUSÃO que corresponde a massa (ou número de átomos) que se difunde por unidade de tempo através de uma área perpendicular à direção do movimento da massa que está se difundindo.

$$J = \frac{M}{(A \cdot t)} \tag{1}$$

onde:

- J = fluxo de difusão.  $\left[\frac{Kg}{m^2}\right]$  ou  $\left[\frac{t}{m^2}\right]$
- dade de átomos)
- A = área da seção transversal
- t = tempo

A velocidade de difusão pode ainda ser avaliada sob duas condições conhecidas na engenharia química:

· Difusão em estado estacionário

 Difusão em estado não estacionário (condições transientes)

#### DIFUSÃO EM ESTADO ESTACIONÁRIO Condições:

- J não varia com o tempo.
- J não varia com a posição.

PRIMEIRA LEI DE FICK: relaciona o fluxo com o gradiente de concentração

$$J = D \cdot \frac{\Delta c}{\Delta x} \tag{2}$$

onde:

- $J = fluxo([\frac{atm}{cm^2}])$
- D = Coeficiente de difusão  $\left[\frac{cm^2}{s}\right]$  valores tabelados; dependente da tempe-
- $\frac{\Delta c}{\Delta x}$  gradiente de concentração
- O sinal negativo indica que o fluxo ocorre no sentido da maior para a menor concentração.

DIFUSÃO EM ESTADO NÃO- ESTACIONÁ-Segunda lei de Fick:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \tag{3}$$

- · Ocorre na maioria das situações praticas que envolve difusão em sólidos.
- Tanto o fluxo de difusão quanto o gradiente de concentração variam com o tempo em uma determinada posição.
- Ocorre acúmulo ou esgotamento dos componentes que estão se difundindo.
- · Sendo especificadas as condições de contorno para a segunda Lei de Fick, podem-se obter soluções que são funções que representam as concentrações em termo de posição e tempo (C=f(x,t)).
- Uma solução prática importante refere-se aà concentração constante de soluto na superfície do sólido  $(C_s)$  e à distribuição uniforme dos átomos do soluto no interior do sólido antes da difusão ocorrer  $(C_0)$

• M = massa transportada (ou quantidade de átomos)
$$\frac{C_X - C_0}{C_S - C_0} = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right), \quad \text{onde } C_X = C = f(x, t)$$
(4)

Onde:

- x = condição á superfície
- C<sub>x</sub> = Concentração à profundidade x, após tempo t
- $C_0$  = Concentração inicial da espécie

•  $C_s$  = Concentração na superfície

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^Z e^{-y^2} dy \tag{5}$$

Função matemática (Função Erro de Gauss) cujos valores são tabelados.

Se aplica a casos de difusão de gás em sólido (ex: processos de cementação)

CALCULO DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO

$$D = D_0 e^{\left(\frac{-Q_d}{RT}\right)} \tag{6}$$

- $D_0$  constante independente da T, em  $\frac{m^2}{s}$  valores tabelados.
- Q<sub>d</sub> energia de ativação para a difusão

#### 28.4.4 FATORES OUE INFLUEN-CIAM A DIFUSÃO

- · Temperatura
- · Espécies em difusão
- Estrutura cristalina da matriz

A difusão é um processo termicamente ativado e a taxa de difusão depende do par soluto-solvente e de suas estruturas cristali-

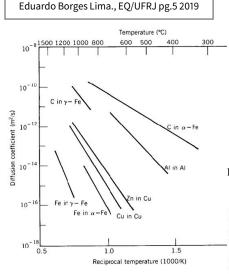
#### INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA

À medida que a temperatura aumenta, a energia térmica disponível e o número de lacunas aumentam → maior difusão

$$\mathbf{n}_{\ell} = \mathbf{n} \mathbf{e}^{\left(\frac{-\mathbf{Q}_{\ell}}{\mathbf{R}\mathbf{T}}\right)} \tag{7}$$

Onde:

- $\mathbf{n}_{\ell} = \text{número de lacunas por } cm^3$
- n = numero de átomos por cm<sup>3</sup>
- $Q_{\ell}$  = energia para produzir o movimento de um mol de átomos  $\left[\frac{cal}{mol}\right]ou\left[\frac{J}{mol}\right]$
- R = constante dos  $8,31 \frac{J}{mol.K}$  ou 1,987  $\frac{cal}{mol.K}$
- T = temperatura (K)



- Influência da temperatura
- Influencia das especies em difusão
- Influencia das estruturas cristalinas

#### Difusão em materiais cerâmicos

- Mecanismos por lacunas
- Lacunas ocorrem em pares (defeito de Schttky)
- Difusão de íons de cargas opostas
- A condutividade elétrica de materiais cerâmicos é função do coeficiente de difusão.

#### 29 Diagrama de Fazes

Def: O diagrama de fases de um dado sistema indica que tipo de microestrutura estará presente, em uma determinada temperatura e composição. É um diagrama termodinâmicos, que não indica a velocidade das reações.

A solubilidade é um dos fatores que interferem diretamente na formação de uma ou mais fases. Pois, quando o sistema ultrapassar o limite de solubilidade uma segunda fase será

Uma liga metálica policristalina pode apresentar mais de um fase.

A figura abaixo mostra como a solubilidade uma determinada substância em relação a outra pode alterar em função da temperatura.

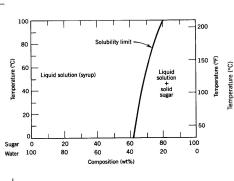
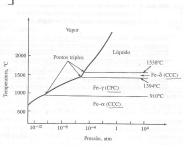
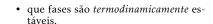


Diagrama de fases de substância pura:



A partir do DIAGRAMA DE FASES, para um dado teor de soluto e uma dada temperatura podemos predizes:

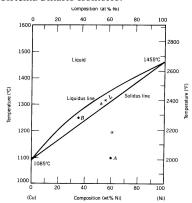


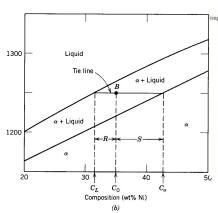
- a composição de cada uma delas
- a quantidade de cada uma delas

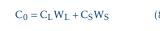
### 30 Solubilidade entre Componentes

Sistema Binário Isomorfo: com solubilidade total no líquido e no sólido.

Sistema Binário Isomorfo:





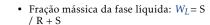


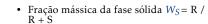


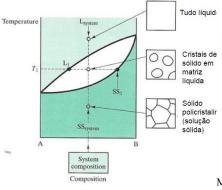
$$W_{S} = \frac{(C_{0} - C_{L})}{(C_{S} - C_{L})} \tag{10}$$

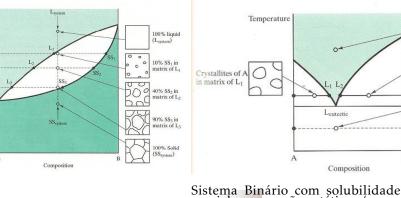
$$W_L = \frac{(C_S - C_0)}{(C_S - C_L)} \tag{11}$$

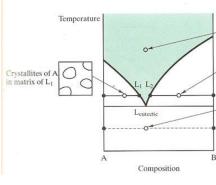
No diagrama:

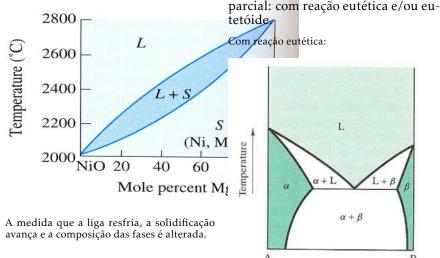












Sistema Binário sem qualquer solubilidade: sem formação de solução solida.

2800

2600

2400

2200

2000

Temperature

A

Eutectic

emperature

NiO

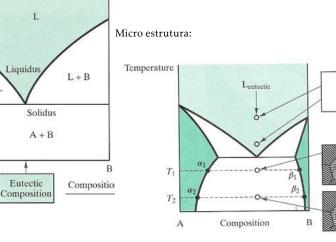
20

40

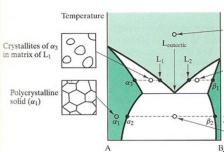
Temperature (°C)

 $L \leftrightarrow S_1 = S_2$ (12)

Composition



Microestrutura:



Composition

#### Baseado nas listas de exercícios 31 Redes Cristalinas

- NC: Número de Coordenação
- FE: Fator de empacotamento

Cubo simples - CS

- NC: 6;
- FE:  $\frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{3} = 0.52$ ;
- Rel: a = 2R;

Cúbico de Corpo Centrado - CCC

- NC: 8
- FE:  $2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{r^3} = 0.68$
- Rel:  $a = \frac{4R}{\sqrt{2}}$

Cúbico de Faces Centradas - CFC

- FE:  $4 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{r^3}$  0,74
- Rel:  $a = \frac{4 \cdot R}{\sqrt{2}}$

#### Hexagonal

- NC: 12
- FE: 0,73 (=CFC)
- Rel: a = 2R

Coordination number	Radius ratio, r/R	Coordination geometry
2	$0 < \frac{r}{R} < 0.155$	0-0
3	$0.155 \le \frac{r}{R} < 0.225$	Å
4	$0.225 \le \frac{r}{R} < 0.414$	<b>X</b>
6	$0.414 \le \frac{r}{R} < 0.732$	
8	$0.732 \leq \frac{r}{R} < 1$	
12	1	

#### Raios Iônicos para Vários Cátions e Ânions (para um Número de Coordenação de 6)

Cátion	Raio Iônico (nm)	Ânion	Raio Iônico (nm)
Al <sup>3+</sup>	0,053	Br-	0,196
Ba <sup>2+</sup>	0,136	Cl-	0,181
Ca <sup>2+</sup>	0,100	F-	0,133
Cs <sup>+</sup>	0.170	I-	0,220
Fe <sup>2+</sup>	0.077	$O^{2-}$	0,140
Fe <sup>3+</sup>	0,069	S2-	0,184
K <sup>+</sup>	0,138		
$Mg^{2+}$	0,072		
Mn <sup>2+</sup>	0.067		
Na <sup>+</sup>	0,102		
Ni <sup>2+</sup>	0,069		
Si <sup>4+</sup>	0.040		
Ti <sup>4+</sup>	0.061		

#### ação Vol pela Mudança de Estru- 34 Cristalina

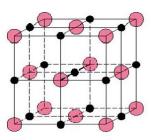
BAo avaliar redução de volume resultada pela mudança de estrutura cristalina de um material que durante o seu aquecimento/resfriamento devemos levar em consideração o número de átomos que cada uma das estruturas comporta. Outro ponto importante é levar em consideração que o número de átomos é constante e portanto haverá variacão na número de células unitárias formadas.

#### 33 Estrutura dos materiais Cerâmicos

O posicionamento das partículas nos materiais cerâmicos depende da relação entre os raios(cátion/ânion) e das cargas envolvidas. Nos vazios (sítios ou interstícios) da rede cristalina se posicionam partículas diferentes das que existem na rede cristalina principal. Em redes compactas há espaços intersticiais, onde as partículas ficam equidistantes do centro do espaço vazio.

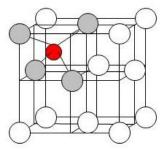
#### Posições octaédricas na rede cfc:

- NC: 6
- Local:arestas (3 sítios) + centro da célula unitária
- Total: 4 partículas (1 por partículas da célula unitária)



Posições tetraédricas na rede cfc:

- NC: 4
- Local:posições do tipo  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$
- Total: 8 partículas (2 por partículas da célula unitária)



#### Contorno de grãos:

- Formada entre cristais (contornos de grãos) ou nas superfícies externas.
- No contorno dos grãos, os átomos não estão à mesma distância uns dos outros. Há tensões de tração e compres-
- Influenciam nas propriedades físicas (ex: resistência mecânica) e químicas.
- Ajuste do tamanho dos grãos → uma das formas de controle das propriedades de um metal.
  - Ex: Reduzindo o tamanho dos grãos, há aumento do área de contorno de grão, diminuindo a distância percorrida pelas discordâncias aumento da resistência mecânica do material.

#### 35 Tipos de soluções de materiais metálicos

- · Soluções sólidas:
  - intersticial
  - Substitucional:
    - \* Ordenada
    - \* Ao acaso

#### 36 Regras de Hume-Rothery para solubilidade

- Variação % causada pela diferença entre raios < 15% (evitar distorções na rede): raio soluto = raio solvente/
- · Mesma estrutura cristalina;
- · Eletronegatividades semelhantes
- Mesma valência.

Sistema	∆ Raios (%)	Solubilidade (%)
Cu-Zn	3,9	38,3
Cu-Pb	36,7	0,1
Cu-Ni	-2,3	100
Cu-Al	11,7	16,4

#### 37 Definições

tária.

Numero de Coordenação: número de partículas que envolvem uma partícula central. Fator de empacotamento: volume de átomos numa célula unitária / volume da célula uni-

#### 38 Direções Cristalográficas

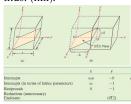
A crystallographic direction is defined as a line between two points, or a vector. The following steps are used to determine the three directional indices:

- 1. A vector of convenient length is positioned such that it passes through the origin of the coordinate system. Any vector may be translated throughout the crystal lattice without alteration, if parallelism is maintained.
- 2. The length of the vector projection on each of the three axes is determined; these are measured in terms of the unit cell dimensions a, b, and c.
- 3. These three numbers are multiplied or divided by a common factor to reduce them to the smallest integer values.
- 4. The three indices, not separated by commas, are enclosed in square brackets, thus: [uvw]. The u, v, and w integers correspond to the reduced projections along the x, y, and z axes, respectively.



#### 39 Planos Cristalográficos

- 1. If the plane passes through the selected origin, either another parallel plane must be constructed within the unit cell by an appropriate translation, or a new origin must be established at the corner of another unit cell.
- 2. At this point the crystallographic plane either intersects or parallels each of the three axes; the length of the planar intercept for each axis is determined in terms of the lattice parameters a, b, and c.
- 3. The reciprocals of these numbers are taken. A plane that parallels an axis may be considered to have an infinite intercept, and, therefore, a zero index.
- 4. If necessary, these three numbers are changed to the set of smallest integers by multiplication or division by a common factor.3
- 5. Finally, the integer indices, not separated by commas, are enclosed within parentheses, thus: (hkl).



#### Densidade Teórica

$$\rho = \frac{nA}{V_c N_{\rm A}} \tag{13}$$

• n = number of atoms associated with each unit cell

- A = atomic weight
- $V_C$  = volume of the unit cell
- $N_A$  = Avogadro's number 16.022 · 10<sup>23</sup> atoms

#### 41 Densidade Linear

$$LD = \frac{nmerodetomoscentradosnadireodovetor}{tamanhodovetordireo}$$
(14)

#### 42 Densidade Planar

$$PD = \frac{nmerodetomoscentradosnoplano}{readoplano}$$
 (15)

#### 42.0.1 Fluxo de Difusão

A velocidade com que ocorre a difusão é avaliada em termos de FLUXO DE DIFUSÃO que corresponde a massa (ou número de átomos) que se difunde por unidade de tempo através de uma área perpendicular à direção do movimento da massa que está se difundindo.

$$J = \frac{M}{(A \cdot t)} \tag{16}$$

- J = fluxo de difusão.  $\left[\frac{Kg}{m^2}\right]$  ou  $\left[\frac{t}{m^2}\right]$
- M = massa transportada (ou quantidade de átomos)
- A = área da seção transversal
- t = tempo
- Difusão em estado estacionário
- · Difusão em estado não estacionário (condições transientes)

DIFUSÃO EM ESTADO ESTACIONÁRIO Condições:

- J não varia com o tempo.
- J não varia com a posição.

PRIMEIRA LEI DE FICK: relaciona o fluxo com o gradiente de concentração

$$J = D \cdot \frac{\Delta c}{\Delta x} \tag{17}$$

DIFUSÃO EM ESTADO NÃO- ESTACIONÁ-Segunda lei de Fick:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \tag{18}$$

(13) 
$$\frac{C_X - C_0}{C_S - C_0} = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$
, onde  $C_X = C = f(x)$ 

Onde:

- x = condição á superfície
- $C_x$  = Concentração à profundidade x, após tempo t
- $C_0$  = Concentração inicial da espécie
- $C_s$  = Concentração na superfície

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^Z e^{-y^2} dy$$
 (20)

CALCULO DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO

$$D = D_0 e^{\left(\frac{-Q_d}{RT}\right)} \tag{21}$$

Onde:

- $D_0$  constante independente da T, em  $\frac{m^2}{s}$  valores tabelados.
- $Q_d$  energia de ativação para a difusão  $\left[\frac{J}{mol}\right]$ .